



RTC

应用指南

文档版本 00B03

发布日期 2016-08-01

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2016。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编：518129

网址： <http://www.hisilicon.com>

客户服务电话： +86-755-28788858

客户服务传真： +86-755-28357515

客户服务邮箱： support@hisilicon.com



前 言

概述

本文档主要介绍 RTC 的校准方案，确保 RTC 计时准确。



说明

本文以 Hi3536 为例，未有特殊说明，Hi3521A/20DV300, Hi3531A, Hi3518EV20X/16CV200, Hi3519 V100, Hi3519V101, Hi3559V100 与 Hi3536 完全一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3536	V100
Hi3521A	V100
Hi3520D	V300
Hi3531A	V100
Hi3518E	V200
Hi3518E	V201
Hi3516C	V200
Hi3519	V100
Hi3516C	V300
Hi3519	V101
Hi3559	V100



读者对象

本文档（本指南）主要适用技术支持工程师。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2016-08-01	00B03	第 3 次临时版本发布
2015-11-05	00B02	第 2 次临时版本发布
2015-01-19	00B01	第 1 次临时版本发布



目 录

前 言.....	i
1 概述.....	1
1.1 RTC 芯片分类	1
1.2 RTC 工作模式	1
1.3 温度与频率输出关系	1
2 RTC 的硬件参考电路	3
2.1 硬件参考电路	3
2.1 选择晶体	3
2.2 选择电容	4
3 RTC 固定分频模式的实现	6
4 RTC 校正功能的实现	7
5 RTC 驱动使用说明	8
5.1 编译	8
5.2 使用	8
6 Q&A	11
6.1 振荡器不振	11
6.2 振荡器的输出频率是 200K	11
6.3 振荡频率虽然是 32.768K 附近，但是频率却不准	12



1 概述

1.1 RTC 芯片分类

常见的 RTC 芯片，大致可分为三类：

- 非集成 RTC：只有 RTC 计时电路，不集成晶体、不集成温度补偿电路。这类芯片的计时精度主要取决于外接晶体的精度，而且受温度影响较大。通常在室温环境下，计时精度较高；随着温度升高或降低，计时偏差逐渐增大。
- 集成晶体的 RTC：将 RTC 计时电路与晶体集成，但没有温度补偿电路。这类芯片在室温环境下，计时精度更高。但仍然无法消除温度的影响。
- 集成 RTC：将 RTC 计时电路、晶体、温度补偿电路（含温度传感器）都集成在一颗芯片中，出厂时进行调教。这类 RTC 的计时精度可以做到很高，且由于温补电路的作用，受环境温度的影响很小。

1.2 RTC 工作模式

内置 RTC 可支持固定分频模式：

与非集成 RTC 相同，内置 RTC 的时钟直接采用外部晶体与振荡电路产生的经过分频后的时钟，工作时分频比固定不变。这种工作模式下，RTC 计时精度取决于外接晶体的频率精度，而且受环境温度影响。在非集成 RTC 这类芯片适用的场景，可以选择内置 RTC 替代外置非集成 RTC，节省一些器件成本。

Hi3536 RTC 无内置温度补偿电路，只支持工作在固定分频模式，若 RTC 时钟的频偏较大，可通过调节 RTC 的分频系数来微调 RTC 的时钟频率。对计时精度有严格要求的客户，建议选择集成晶体的 RTC，或者带有温度补偿的 RTC。

1.3 温度与频率输出关系

RTC 计时时钟计算公式为：RTC 的计时时钟
= 内部振荡电路产生的时钟 / 分频比 (327.xx)。

当温度变化时，内部振荡电路产生的时钟受到影响也会变化，此时可通过调节分频比来确保 RTC 计时时钟恒定。32K 晶体的输出振荡频率与温度的关系如图 1-1 所示。

图1-1 温度与晶体频率输出关系

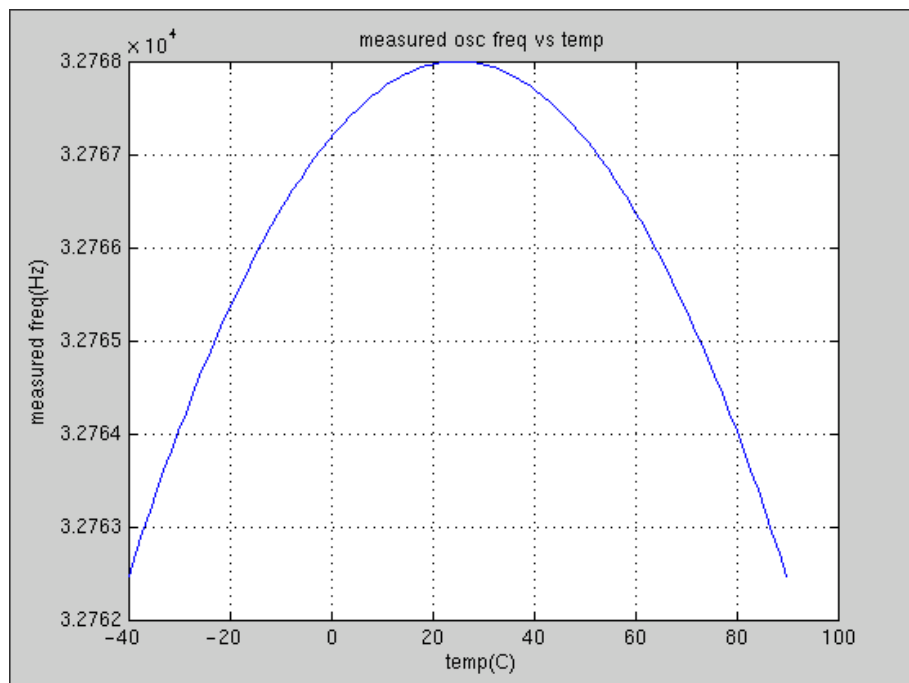


图 1-1 中的曲线可以公式表示： $F = (K_s * (T - T_0)^2 + 1 + C) * 32768$

其中：

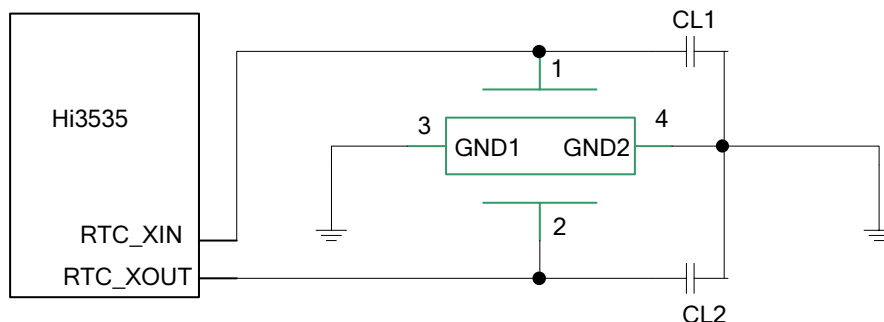
- F 为晶体在温度 T 下的振荡频率，单位为 Hz。
- K_s 为抛物线二次项系数，和选取的晶体相关，图 1-1 中的 K_s 为 $-4 \times 10^{-8} / ^\circ\text{C}^2$ 。
- T_0 是抛物线的转折温度点，一般为 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 。图 1-1 中的值为 24.94°C 。（RTC 中一个温度码字表示 $(140^\circ\text{C} - (-40^\circ\text{C})) / 255 = 0.705882^\circ\text{C}$ ，温度码字和温度的对应关系请参见《RTC 晶体校正参数生成表》）
- C 为晶体在转折温度点的频率偏差，图 1-1 中为 0。C 受以下两部分因素影响：
 - 负载电容
 - 晶体差异

2 RTC 的硬件参考电路

2.1 硬件参考电路

RTC 的硬件参考电路如图 2-1 所示，主要涉及晶体和电容的选择。

图2-1 RTC 晶体的硬件参考电路



2.1 选择晶体

选择晶体需要注意以下几个指标：

- 标准负载电容（Load capacitance/CL）：晶体的标准负载电容，晶体对负载电容有着严格的规定，只有实际负载电容和晶体的 SPEC 中的负载电容一致时，晶体频率才能达到标称频率。

芯片中的晶体振荡电路针对 CL=12.5pF 的晶体设计，且在 32.768K 晶体市场中，CL=12.5pF 的晶体为市场主流，请选用此规格晶体。如果想选用其他规格的晶体，需要按照影响 RTC 精度的因素选择匹配电容。

- 串联电阻（Series resistance/Rs/ESR）：晶体的谐振腔等效串联电阻，当 ESR 越大，表示晶体越难以驱动。晶体规格中会指出 Rs 的典型值与最大值。

芯片晶体振荡电路适用于 Rs 最大值<70KΩ 的晶体，保证 RTC_XOUT 的电压幅度大于或等于 850mV，请选用满足此规格的晶体。

- 最大驱动级别 (Max Drive Level/DL): 表示晶体最大的振荡幅度, 当振荡幅度超过一定幅度时, 晶体容易发生损坏。

Hi3536 芯片晶体振荡电路内部限制了 RTC_XIN 与 RTC_XOUT 管脚振荡的振荡幅度, 可以通过以下公式估计电路工作时的实际 Drive Level, 并确定此值小于晶体规格中规定的最大 Drive Level。

$$DL_{actual} = 0.5 * R_{s_max} * (\pi * f * V_{pp_XIN} * CL * 2)^2$$

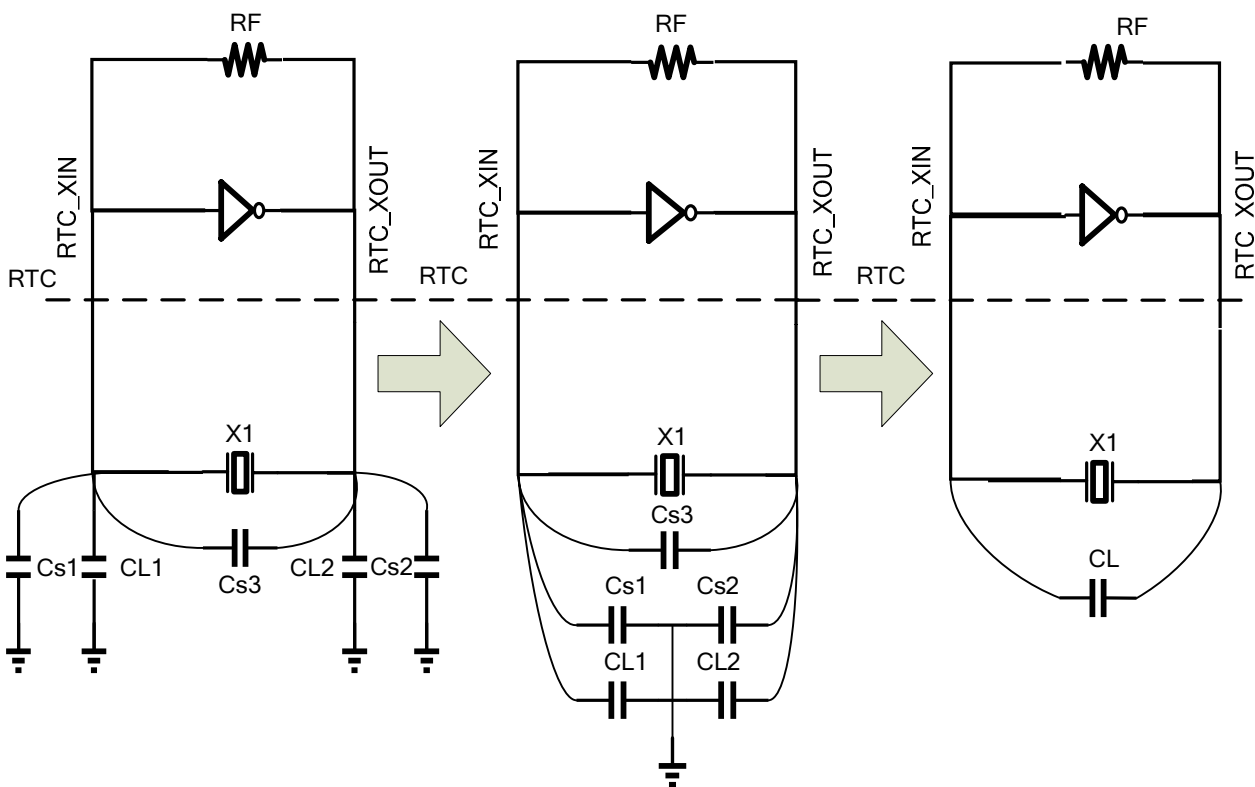
其中:

- R_{s_max} 为晶体规格书中的串联电阻的最大值
- f 为晶体的谐振频率
- V_{pp_XIN} 为示波器测量的 RTC_XIN 管脚的 peak to peak 电压
- CL 为晶体规格书的标准负载电容

2.2 选择电容

实际 CL 的示意图如图 2-2 所示。

图2-2 实际 CL 的示意图



Pierce 振荡器中, 一般将 CL1 与 CL2 取相同的值, 可以通过以下公式来确定 CL1 与 CL2 的取值。

$$CL1 = CL2 = CL_SPEC * 2 \sim 5pF$$



其中 CL_SPEC 为晶体规格书中规定的标准负载电容，3~5pF 代表的 PCB 板可能引入的杂散电容。以 12.5pF 的晶体为例，CL1 与 CL2 一般取值为 $12.5\text{pF} \times 2 - 3\text{pF} = 22\text{pF}$ 。因为杂散电容随 PCB 板设计不同而变化，故亦可确定 PCB 板以后，通过选取不同容值的 CL1 来获得最接近 32.768K 的输出频率。



3 RTC 固定分频模式的实现

RTC 在固定分频模式下不进行温度补偿。RTC 的时钟直接采用外部晶体与振荡电路产生的进行 327.xx 分频后的时钟，RTC 精度取决于外部晶振提供时钟的准确性。小数分频的分频系数可以调整。本方案与非集成 RTC 芯片具有类似精度。

固定分频模式配置比较简单，涉及的 RTC 内部寄存器有 2 个：0x51 和 0x52。

0x51 和 0x52，这两个寄存器连在一起为一个 16bit 的寄存器，它们的值决定小数分频的分频系数，具体计算方法如下：

分频系数=327+（寄存器读取值/3052）

例如：0x51 的值为 0x8，0x52 寄存器的值为 0x1b，它们连在一起的 16bit 的值为：0x81b。0x81b 的十进制为 2075，分频系数=327+（2075/3052）=327+0.68=327.68。

小数分频的分频系数可以微调是为了使分频后的时钟更加接近 100Hz，这样 RTC 的精度会有所提高。调节分频系数通常应用在时间统一偏快或者偏慢的情况。例如，假设晶振的输出频率为 32767.00Hz，若使用默认分频系数 327.68，则分频后的时钟是 99.97Hz，时钟会偏慢。若把分频系数设置为 327.67，则分频后的时钟为 100Hz，会改善时钟偏差的情况。



4 RTC 校正功能的实现

Hi3536 不支持 RTC 逻辑校正，若 RTC 时钟的频偏较大，可通过调节 RTC 的分频系数来微调 RTC 的时钟频率。



5 RTC 驱动使用说明

5.1 编译

在 RTC 目录下执行下述命令即可生成对应的驱动 hirtc.ko 及示例程序 test。

```
cd rtc
make
make test
```

5.2 使用

将 hirtc.ko 拷贝到单板，并执行如下命令插入驱动模块：

```
insmod hirtc.ko
```

RTC 驱动提供的功能通过单板上运行的 test 示例程序说明，如图 5-1 所示。

图5-1 示例程序用法

```
Usage: ./test [options] [parameter1] ...
Options:
  -s(set)           Set time/alarm,      e.g '-s time 2012/7/15/13/37/59'
  -g(get)           Get time/alarm,      e.g '-g alarm'
  -w(write)         Write RTC register,  e.g '-w <reg> <val>'
  -r(ead)           Read RTC register,   e.g '-r <reg>'
  -a(alarm)         Alarm ON/OFF',      e.g '-a ON'
  -reset            RTC reset
  -b(battery monitor) battery ON/OFF,   e.g '-b ON'
  -f(frequency)     frequency precise adjustment, e.g '-f <val>'
```

设置获取时间

通过如下命令可设置 RTC 时间：

```
./test -s time <year/month/day/hour/minute/second>
```



通过如下命令可获取 RTC 时间：

```
./test -g time
```

设置获取闹钟时间

通过如下命令可设置 RTC 闹钟时间：

```
./test -s alarm <year/month/day/hour/minute/second>
```

通过如下命令可获取 RTC 闹钟时间：

```
./test -g alarm
```

通过如下命令设置闹钟到期是否产生中断，驱动中断例程由用户根据需求自由补充。

```
./test -a ON/OFF
```

读取、设置 RTC 内部寄存器

通过如下命令可读取 RTC 内部寄存器，此功能多用于辅助调试，比如读取内部温度传感器采集的温度值，读取设置的 RTC 更新温度值等。

```
./test -r <reg>
```

通过如下命令可设置 RTC 内部寄存器，此功能多用于辅助调试。

```
./test -w <reg> <value>
```

reg 取值，请参见《Hi3536 H.265 编解码处理器用户指南.pdf》3.9 节实时时钟部分。

复位 RTC 模块

通过如下命令可复位 RTC 模块。

```
./test -reset
```

固定分频模式分频系数微调设置

通过如下命令可设置分频系数从而达到调整时钟的快慢效果。

```
./test -f <val>
```

<val>值为将要设置的分频系数的 10000 倍，例如要设置分频系数为 327.60，则 val=3276000。通过直接敲“./test -f”命令可以查看当前分频系数。分频系数可以配置范围为：327.60~327.70。

打开、关闭电池电量监测功能

通过如下命令可打开 RTC 电池电量监测功能。

```
./test -b ON
```

通过如下命令可关闭 RTC 电池电量监测功能。



```
./test -b OFF
```

用户接口

请参看 hi_rtc.h 文件。



6 Q&A

6.1 振荡器不振

【现象】

32.768K 时钟无输出，RTC 计时电路中的秒寄存器值恒定不变。

【分析】

使用示波器探头观察 RTC_XIN 管脚振荡波形，引起不同的振荡波形的情况有以下几种：

- 如果无振荡波形，可能是晶体损坏。
- 如果有 32K 左右频率正弦波，且 peak to peak 幅度小于 600mV，则可能是因为 CL1 与 CL2 过大，导致振荡电路驱动不足，从而幅度偏小，振荡波形无法通过后续的施密特触发器。
- 如果有 200K 左右频率的正弦波，且 peak to peak 幅度小于 600mV，则可能是因为 CL1 与 CL2 偏小，导致振荡电路振荡到 200K 频点，且由于 200K 频点振幅较小，所以无法通过后续的施密特触发器。

【解决】

- 如果确定晶体损坏，请更换晶体。
- 如果为 32K 左右频率正弦波，幅度不够，请检查 CL1 与 CL2 是否偏大，并更换正确的电容。
- 如果为 200K 左右频率正弦波，幅度不够，请检查 CL1 与 CL2 是否偏小，并更换正确的电容。

6.2 振荡器的输出频率是 200K

【现象】

32.768K 时钟输出频率接近 200K，RTC 计时电路中的秒寄存器值每秒钟增加 6。

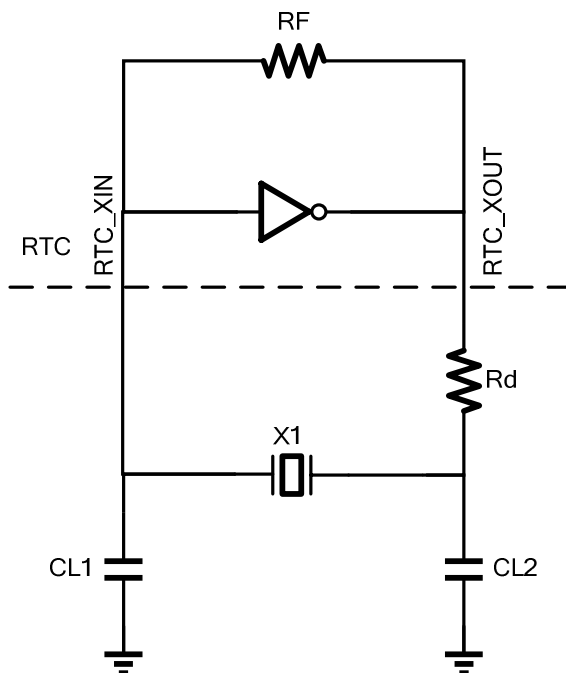
【分析】

因为 32.768K 晶体存在 6.1 倍频的谐振点，如果晶体有异常，则可能振荡到 6 倍频附近。

【解决】

建议首先检查 CL1 与 CL2 是否偏小；如果 CL1 与 CL2 为正确值，但振荡频率仍然为 200K，则可以在电路中添加如图 6-1 所示的 R_d ， R_d 取值为 $1/(2\pi \times 32768 \times CL2)$ ， R_d 与 CL2 可以形成一个 RC 滤波器，降低 6.1 倍频处的环路增益。

图6-1 200K 振荡解决方案电路



注意：一般情况不建议增加 R_d ，如果采用增加 R_d 的方法，需要确定 RTC_XOUT 管脚信号幅度不会过小。

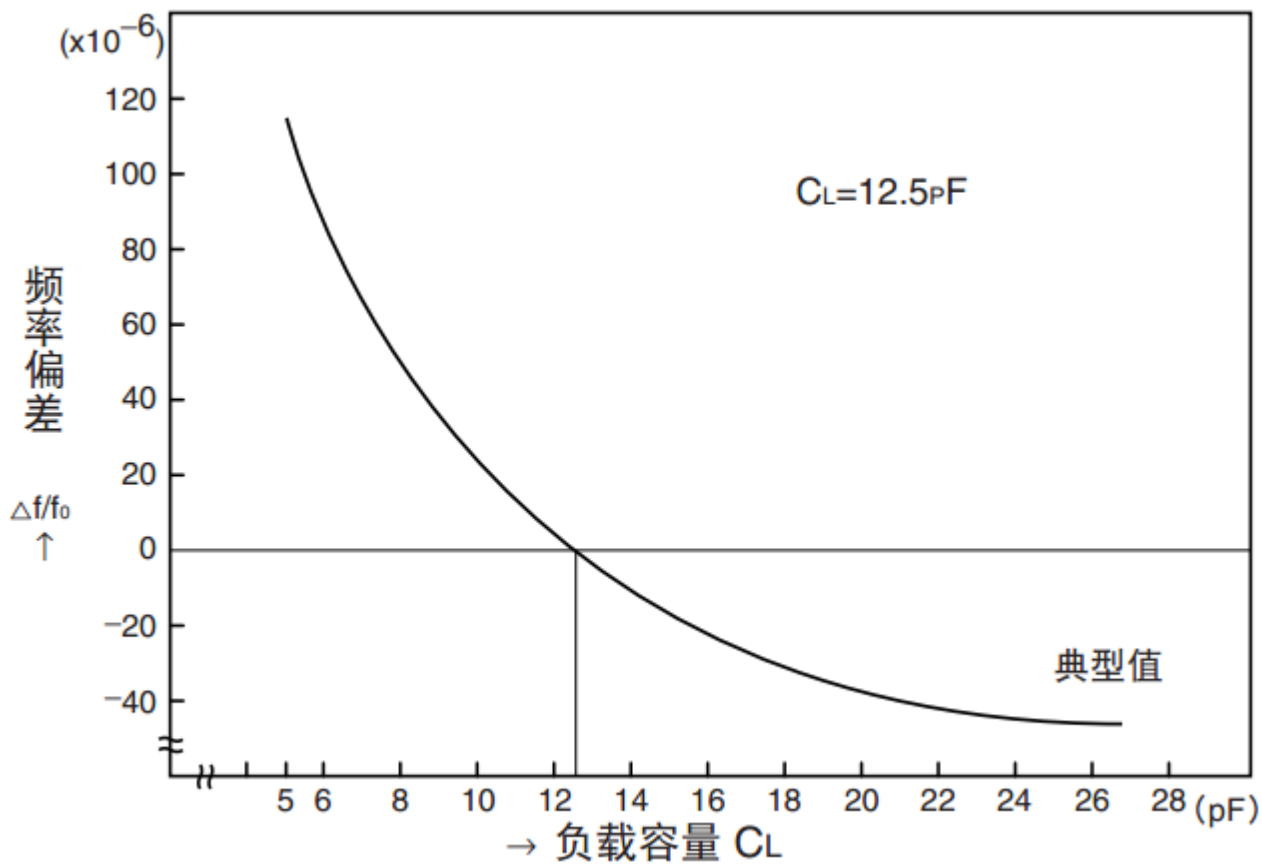
6.3 振荡频率虽然是 32.768K 附近，但是频率却不准

【现象】

32.768K 时钟输出频率偏离 32.768K。

【分析】

振荡电路振荡频率主要由晶体和负载电容共同保证，晶体本身确定了频率的大致范围（即图 6-2 所示中的 0 偏差对应的频率），而实际负载电容的大小则确定了频率的偏移量（即图 6-2 所示中的实际频率偏离 0 的值）。

图6-2 频率偏差和负载容量 C_L 的关系


【解决】

如果频率偏离了 32.768K，首先需要确认晶体管脚弯折不会对内部晶体部分施加应力，并确定焊接过程中的温度符合 datasheet 规范；其次，检查 CL1 与 CL2 取值是否正确，并更换正确的电容。